

## 明細書

### プローブカード及びプローブシートまたはプローブカードを用いた半導体検査装置および半導体装置の製造方法

#### 技術分野

[0001] 本発明は、プローブカード、及びプローブシートまたはプローブカードを用いた半導体検査装置および半導体装置の製造方法に関する。

#### 背景技術

[0002] 半導体素子回路をウェハに形成後に行う半導体装置の製造工程のうち、主に検査工程の流れの一例を、代表的な半導体装置の出荷形態であるパッケージ品、ベアチップおよびCSPを例にして、図12に示した。

[0003] 半導体装置の製造工程では、図12に示したように大きく分けて次の3つの検査が行われる。まず、ウェハに半導体素子回路および電極を形成したウェハ状態で行われ、導通状態および半導体素子の電気信号動作状態を把握するウェハ検査、続いて半導体素子を高温や高印加電圧等の状態において不安定な半導体素子を摘出するバーンイン検査、そして半導体装置を出荷する前に製品性能を把握する選別検査である。

[0004] このような半導体装置の検査に用いられる装置(半導体検査装置)の従来技術として、米国特許第5461326号がある。米国特許第5461326号の技術は、薄膜支持フレームと、この支持フレームに固定されたフレキシブルな薄膜と、試験される装置の接触パッド上に加圧されるように薄膜の外面の中央領域に設けられた複数の試験プローブ接触子と、各プローブ接触子を試験回路へ接続する薄膜上の複数の導電性トレースと、プローブ試験接触子が試験されるべき装置の接触パッド上に加圧されたときに前記薄膜中央領域を自動的に回動させる手段(中央領域の薄膜の内面に固定された加圧プレートとこの加圧プレートの中央をピボット的に加圧する頭部が半球形のピボットポストからなる)とを具備した自己水平化薄膜試験プローブが記載されている。

[0005] 他の従来技術として、米国特許第6305230号がある。米国特許第6305230号の

技術は、支持部材と、先端を尖らせた接触端子をプロービング側の領域部に複数併設し、該各接触端子に電気的につながって引き出される複数の引き出し用配線と絶縁層を挟んでグランド層とを有する多層フィルムと、多層フィルムにおける裏側に固定された枠と、押さえ部材と、各接触端子の先端を各電極に接触させるための接触圧を前記支持部材から前記押さえ部材に対して付与する接触圧付与手段と、前記接触端子群の先端面を前記電極群の面に接触させる際、接触端子群の先端面が電極群の面に倣って平行出しするコンプライアンス機構とを備えた接続装置、及び該接続装置を検査対象物の電極に接触させることにより、電気的接続を取り検査を行う検査システムが記載されている。

### 発明の開示

- [0006] しかし、米国特許第5461326号では、接触端子を接触端子を加圧するために薄膜の周辺部を固着し、薄膜全体が伸びて張った状態で、加圧する方式である。したがって加圧プレートと被検査対象物との平行出しは、薄膜の張力に依存しており、また、薄膜を配線基板下面から張り出させる場合、大きな引っ張り力が薄膜にかかるため配線が断線しやすくなり、薄膜の張り出し量に限界がある。
- [0007] また、薄膜が伸びた状態となるため、接触端子先端部の配置が拡大し、先端位置精度の確保が困難となる。さらに、ピボットポストと加圧プレートには、初期的な平行出し機構がなく、傾いた状態で被検査対象物に片当たりしてしまう可能性もあり、被検査対象物を損傷する恐れが大きい。
- [0008] 一方、米国特許第6305230号では、接触圧荷重制御も、平行出し倣いも、センターピボットの周囲に設けられたスプリングプローブで行われるため、両者の制御動作を両立するようにスプリング圧を設定することが難しく、さらに押さえ部材が横方向にずれてしまうという課題を有していた。また、接触端子先端部の位置精度は、薄膜の張り出し量に微妙に連動して変動するため、先端位置精度の確保が難しいという課題を有している。
- [0009] 以上説明したように、何れの上記米国特許の技術においても、半導体素子等の被検査対象物の高密度化に伴う狭ピッチ多ピンに対応したプロービングを、被検査対象物および接触端子を損傷することなく、接触端子先端の位置精度を確保して、低

荷重で安定し、組み立てが容易な方式を実現しようとする点について、満足できるものではなかった。

- [0010] また、近年の半導体素子の高集積化に伴って、電極の狭ピッチ化(例えば0.1mm程度以下)や高密度化が更に進むようになり、加えて、信頼性をより明確に把握するための高温(例えば85°C～150°C)での動作試験が実施される傾向になってきているため、これらに対応できる検査装置が望まれている。
- [0011] 本発明の目的は、接触端子の先端位置精度を確保し、狭ピッチの電極構造を有する半導体素子を確実に検査可能なプローブシートを有するプローブカード及び該プローブシートまたはプローブカードを用いた検査方法及び装置を提供することである。
- [0012] 上記目的を達成するために、本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば次のとおりである。
- (1) 被検査対象に設けられた電極と接触する複数の接触端子と、該接触端子各々から引き出された配線と、該配線と電気的に接続される電極を有する多層配線基板を有するプローブカードであって、該多層配線基板の電極と該配線とは、周辺電極を介して電気的に接続されている。
- [0013] (2) 被検査対象の電気的特性を検査するテスタと電気的に接続される多層配線基板と、該多層配線基板の電極に接続される複数の周辺電極と被検査対象に設けられた電極と接触する複数の接触端子とを有するプローブシートとを有するプローブカードであって、該プローブシートは、さらに、該複数の接触端子を取り囲むように形成された第1の金属膜と、該第1の金属膜を取り囲むように形成された第2の金属膜とを有する。
- [0014] (3) 半導体装置の製造方法は、  
ウエハに回路を作りこみ、半導体素子を形成する工程と、  
該半導体素子の電気的特性を検査する工程と、  
該ウエハをダイシングし、該半導体素子ごとに分離する工程とを備え、  
該半導体素子の電気的特性を検査する工程では、  
該半導体素子の電極に接触する複数の接触端子と、該複数の接触端子を取り囲

むように形成された第1の金属膜と、該第1の金属膜を取り囲むように形成された第2の金属膜とを有するプローブシートを用い、

該プローブシートの該第1の金属膜が形成された領域及び該複数の接触端子が形成された領域に押し付け力を付与しつつ、該複数の接触端子を該半導体素子に設けられた電極に接触させて検査する。

本発明の他の目的、特徴及び利点は添付図面に関する以下の本発明の実施例の記載から明らかになるであろう。

### 発明を実施するための最良の形態

- [0015] 以下、発明の実施の形態を、図面を用いて詳しく説明する。なお、発明の実施の形態を説明するために添付する各図面において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。
- [0016] 本明細書中では、主な用語を次のように定義する。半導体装置とは、その形態に関わらず、回路が形成されたウエハ状態のもの(例えば、図1A)であっても、半導体素子(例えば、図1B)であっても、その後パッケージされたもの(QFP、BGA、CSP等)であっても構わない。尚、図1Bは被検査対象の一例であり、電極3の配列は、周辺電極配列であるか全面電極配列であるかを問わない。プローブシートとは、被検査対象の電極と接触する接触端子とそこから引き出された配線を有するシートをいう。プローブカードとは、被検査対象の電極と接続して、測定器であるテスタと該被検査対象とを電気的に接続するコネクタとして機能する構造体(例えば、図2A、2Bに示す構造体)をいう。
- [0017] 本発明に係るプローブカードの構造について図2A、2Bおよび図3A、3Bを用いて説明する。

図2Aは、本発明に係るプローブカードの第1の実施の形態の要部を示す断面図であり、図2Bは、その主要部品を分解して図示した斜視図である。本プローブカードの第1の実施の形態は、支持部材(上部固定板)7と、該支持部材7にねじ止めされる中間板24の中央部に高さ方向に調整可能に固定され、下部先端に突起部12aをしてセンターピボットの働きをし、該突起部12aの先端を支点として可動する押し駒22を介してプローブシート6に押圧力を付与するばね12bを装填したスプリングプロ

プ12と、該プロープシート6の複数個の接触端子4が形成された領域を囲むように裏面に接着固定された枠21と、プロープシート6の接触端子4が形成された領域の裏面との間にシリコーンシートなどの緩衝材23および押し駒22を中心部に有し、該枠21にねじ止めされる中間板24とを含み構成される。そして、この支持部材7は、該支持部材7に設けられた平行出し調整ねじ25により、プロープカードの接触端子4の面と半導体素子の対応する電極面の平行出しが実施される。

- [0018] 本プロープカードでは、中間板24の中央部に設置したスプリングプロープ12の先端の突起部12aにより微傾動可能に保持された押し駒22に対し、該スプリングプロープ12により所望のほぼ一定の押し付け力(例えば、500ピン程度の場合、押し込み量 $150 \mu\text{m}$ で20N程度)を付与することにより、複数個の接触端子が形成された領域に所望のほぼ一定の押し付け力を付与する構造の、コンプライアンス機構を用いている。なお、押し駒22の上面中央部に突起部12aと係合する円錐溝22aが形成されている。
- [0019] 上記プロープシート6は、図2A、2Bに示すように、シートのプロービング側の中央領域部に半導体素子2の電極群3と接触するための複数個の接触端子4を形成し、該接触端子4の周囲を二重に囲むように金属膜30aおよび枠21に対応した領域に金属膜30bを形成し、プロープシート6の4辺の周辺部に多層配線基板50との信号授受のための複数個の周辺電極5を形成し、該周辺電極5を囲むように周辺電極固定板9に対応した領域に金属膜30cを形成し、該接触端子4と周辺電極5との間に多数の引き出し配線20を形成したプロープシート6で形成される。更に、上記接触端子4を形成した領域のプロープシート6の裏面には、枠21が接着固定され、信号授受のためのプロープシート6の周辺電極5を形成した部分の裏面には、周辺電極固定板9が接着固定される。更に、上記枠21は、中間板24にねじ止めされる。この中間板24には、スプリングプロープ12が固定され、下部先端の突起部12aが、押し駒22の上面中央に形成された円錐溝22aと係合するように構成される。
- [0020] なお、金属膜30aは、図3Bに示したように、複数個の接触端子4の群の中央部に間隔がある場合は、中央部にも金属膜30dを形成してもよい。また、金属膜30cには、位置決め用のノックピン用孔30eおよびねじ挿入用孔30fをパターン形成しておく

ことにより、組み立て性を向上することができる。

- [0021] 例えば、図13に示したように、金属膜30cの位置決め用のノックピン用孔30eおよび多層配線基板50の対応するノックピン用孔50eおよび下押さえ板33のノックピン用孔33eおよび周辺電極固定板9のノックピン用孔9eを用いて、ノックピン34により全体を位置決めして、周辺電極固定板9を下押さえ板33にねじ止め固定する。次に、プロープシート6に周辺電極5の群を囲むように固着した周辺電極固定板9に緩衝材31をはさんで周辺押さえ板32を、周辺電極固定板9のノックピン用孔9eおよび周辺押さえ板32のノックピン用孔32eを用いてノックピン34で位置決めして、下押さえ板33にねじ止め固定することにより、緩衝材31を介して周辺電極5の群を多層配線基板50の電極50aに押し付けて接続する。
- [0022] ここで、プロープシート6の接触端子4の群を二重に取り囲むように円状の金属膜30aおよび(枠21に対応した領域に)金属膜30bを形成することにより、内側の金属膜30aで、該接触端子群の位置精度を確保し、枠21に対応した領域に形成した金属膜30bとその内側の金属膜30aとの間の金属膜30のない柔軟性を有したプロープシート領域で、接触対象のウエハ面の微妙な傾きに金属膜で裏打ちされた部分を保ったまま倣い動作ができる構造が実現可能となる。すなわち、複数の接触端子4が金属膜30aで取り囲むことで、検査動作時に該接触端子が形成された領域に余分な応力が加わるのを防ぐことができ、従って被検査対象の電極との精確な接触が実現できる。加えて、金属膜30を、42アロイあるいはインバーなどのシリコンウエハとほぼ同程度の線膨張率を持った材料を使用することにより、被検査対象(シリコンウエハ)とほぼ一致することができ、高温時でも接触端子先端の位置精度を確保することができる。
- [0023] また、前記したようにプロープシート6の周辺部の周辺電極5の群を囲むように周辺電極固定板9に対応した領域に金属膜30cを形成することにより、プロープシート6の強度を確保でき、該周辺電極群の位置精度を確保することができ、組み立て時の取り扱いも容易となる。加えて、金属膜30cにホトリソマスクによる一括エッチング処理で、位置精度および形状が正確な位置決め用孔およびねじ挿入孔を形成することにより、組み立て作業を容易にすることができます。

[0024] 次に、本発明に係る接続装置の第2の実施の形態を図3A, 3Bを用いて説明する。

図3Aは、本発明に係る接続装置の第2の実施の形態の要部を示す断面図であり、図3Bは、その主要部品を分解して図示した斜視図である。本接続装置の第2の実施の形態における第1の実施の形態と相違する点は、押し駒22に押圧力を付与する手段として、スプリングプローブ12にかえてスプリングプランジャ13および突起状の押さえピン14を用いる点、あるいは該スプリングプランジャ13を固定した中間板24と、支持部材7とを板ばね15で可動な状態で保持する構造を用いる点、あるいは金属膜30aの接触端子群4の中央部に間隔がある場合は、中央部にも金属膜30dを形成する点にある。いずれの変更も、第1の実施の形態の例で開示した構造と必要に応じて組み合わせて実施可能である。

[0025] 尚、所望のほぼ一定の押し付け力を付与するコンプライアンス機構は、上記実施の形態に限らず、種々変更してもよい。

[0026] 次に、前記プローブカードにて用いられるプローブシート(構造体)の一例について、その製造方法を図4A-4Hを参照して、説明する。

[0027] 図4A-4Hは、図2A, 2Bに示すプローブカードを形成するための製造プロセスのうち、特に、型材であるシリコンウェハ80に異方性エッチングで形成した角錐台状の穴を型材として用いて、角錐台状の接触端子先端部および引き出し配線20をポリイミドシートと一緒に形成し、該ポリイミドシートに金属膜をポリイミド接着シートで接合し、該金属膜に補強板および位置決め用ノックピン孔としてエッチング加工して形成したプローブシート6を形成する製造プロセスを工程順に示したものである。

[0028] まず図4Aに示す工程が実行される。この工程は、厚さ0.2-0.6mmのシリコンウェハ80の(100)面の両面に熱酸化により二酸化シリコン膜81を0.5μm程度形成し、ホトレジストを塗布し、フォトリソグラフィ工程により角錐台状の穴をあける位置のホトレジストを除去したパターンを形成した後、該ホトレジストをマスクとし、二酸化シリコン膜81をフッ酸とフッ化アンモニウムの混合液によりエッチング除去して、前記二酸化シリコン膜81をマスクとして、シリコンウェハ80を強アルカリ液(例えば、水酸化カリウム)により異方性エッチングして、(111)面に囲まれた角錐台状のエッチング穴80aを形成する工程が実行される。

- [0029] ここで、本実施例ではシリコンウエハ80を型材としたが、型材としては、結晶性を有するものであればよく、その範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。また、本実施例では異方性エッチングによる穴を角錐台状としたが、その形状は、角錐状でもよく、小さな針圧で安定した接触抵抗を確保できる程度の接触端子4を形成できる形状の範囲で、種々変更可能である。また、接触対象とする電極に、複数の接触端子で接触するようにしてもよいことはいうまでもない。
- [0030] 次に、図4Bに示す工程が実行される。この工程はマスクとして用いた二酸化シリコン膜81をフッ酸とフッ化アンモニウムの混合液によりエッチング除去して、再度シリコンウエハ80の全面を、ウェット酸素中での熱酸化により、二酸化シリコン膜82を、0.5  $\mu\text{m}$ 程度形成し、その表面に導電性被覆83を形成し、次に該導電性被覆83の表面に、ポリイミド膜84を形成し、ついで、接触端子4を形成すべき位置にあるポリイミド膜84を、上記導電性被覆83の表面に至るまで除去する工程が実行される。
- [0031] 上記導電性被覆83としては、例えば、クロムをスパッタリング法あるいは蒸着法により成膜することにより、厚さ0.1  $\mu\text{m}$ 程度のクロム膜を形成して、該クロム膜を形成した表面に銅をスパッタリング法あるいは蒸着法により成膜することにより、厚さ1  $\mu\text{m}$ 程度の銅膜を形成すればよい。該銅膜に数  $\mu\text{m}$ 厚の銅をめっきで形成して、レーザ加工の耐性を増してもよい。上記ポリイミド膜84を除去するには、例えば、レーザ穴あけ加工あるいはポリイミド膜84の表面にアルミニウムマスクを形成してドライエッチングを用いればよい。
- [0032] 次に、図4Cに示す工程が実行される。まず、該ポリイミド膜84の開口部に露出した導電性被覆83に、該導電性被覆83を電極として、硬度の高い材料を主成分として電気めっきして、接触端子4および接続電極部4bを一体として形成する。硬度の高いめっき材料として、例えば、ニッケル8a、ロジウム8b、ニッケル8cを順次にめっきして接触端子4および接続電極部4bを一体として接触端子部8を形成すればよい。
- [0033] 次に、上記の接触端子部8およびポリイミド膜84に導電性被覆86を形成し、ホトリジストマスク87を形成した後、配線材料88をめっきする。
- [0034] 上記導電性被覆として、例えば、クロムをスパッタリング法あるいは蒸着法により成膜することにより、厚さ0.1  $\mu\text{m}$ 程度のクロム膜を形成して、該クロム膜を形成した表

面に銅をスパッタリング法あるいは蒸着法により成膜することにより、厚さ $1\text{ }\mu\text{m}$ 程度の銅膜を形成すればよい。また、配線材料としては、銅を用いればよい。

- [0035] 次に、図4Dに示す工程が実行される。この工程は上記ホトレジストマスク87を除去し、配線材料88をマスクとして導電性被覆86をソフトエッチング除去した後、接着層89および金属膜30を形成し、該金属膜30にホトレジストマスク91を形成するものである。
- [0036] ここで、接着層89としては、例えば、ポリイミド系接着シートあるいは、エポキシ系接着シートを用いればよい。また、金属膜30として、42アロイ(ニッケル42%および鉄58%の合金で線膨張率 $4\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ )あるいはインバー(例えば、ニッケル36%および鉄64%の合金で線膨張率 $1.5\text{ppm}/^{\circ}\text{C}$ )の様な低線膨張率で、かつシリコンウエハ(シリコン型材)80の線膨張率に近い金属シートを、接着層89で配線材料88を形成したポリイミド膜84に貼り合わせて構成することにより、形成されるプロープシート6の強度向上、大面積化が図れるほか、検査時の温度による位置ずれ防止等、様々な状況下での位置精度確保が可能である。この主旨において、金属膜30としては、バーンイン検査時の位置精度確保をねらい、被検査対象の半導体素子の線膨張率に近い線膨張率の材料を用いてもよい。
- [0037] 上記接着工程は、例えば、接触端子部8および配線材料88を形成したポリイミド膜84を形成したシリコンウエハ80と、接着層89および金属膜30を重ね合わせて、 $10\sim200\text{Kgf/cm}^2$ で加圧しながら接着層89のガラス転移点温度( $T_g$ )以上の温度を加え、真空中で加熱加圧接着すればよい。
- [0038] 次に、図4Eに示す工程が実行される。この工程は、上記ホトレジストマスク91により金属膜30をエッチングした後、プロセスリング95を前記金属膜30に接着剤96で固定し、該プロセスリング95に保護フィルム97を接着した後、中央をくりぬいた保護フィルム98をマスクとして二酸化シリコン82をフッ酸とフッ化アンモニウムの混合液によりエッチング除去するものである。金属膜30として、42アロイシートあるいはインバーシートを用いた場合は、塩化第二鉄溶液でスプレー-エッチングすればよい。また、ホトレジストマスクとしては、液状レジストでもフィルム状レジスト(ドライフィルム)でもよい。
- [0039] 次に、図4Fに示す工程が実行される。この工程は上記保護フィルム97および98を

剥離し、シリコンエッチング用保護治具100を取り付けて、シリコンをエッチング除去するものである。例えば、中間固定板100dに、前記プロセスリング95をねじ止めして、ステンレス製の固定治具100aとステンレス製のふた100bとの間にOリング100cを介して装着し、型材であるシリコンウェハ80を強アルカリ液(例えば、水酸化カリウム)によりエッチング除去すればよい。

[0040] 次に、図4Gに示す工程が実行される。この工程は上記シリコンエッチング用保護治具100を取り外し、図4Dと同様にプロセスリング95に保護フィルムを接着し、二酸化シリコン82および導電性被覆83(クロムおよび銅)およびニッケル8aをエッチング除去し、保護フィルムを除去した後、プロープシートの枠21と金属膜30bとの間、および周辺電極固定板9と金属膜30cとの間に接着剤96bを塗布して、金属膜30の所定の位置に固着するものである。

二酸化シリコン膜82は、フッ酸とフッ化アンモニウムの混合液によりエッチング除去し、クロム膜を過マンガン酸カリウム液によりエッチング除去し、銅膜およびニッケル膜8aをアルカリ性銅エッチング液によりエッチング除去すればよい。

なお、この一連のエッチング処理の結果、接触端子表面に露出するロジウムめっき8bを用いるのは、電極3の材料であるはんだやアルミニウム等が付きにくく、ニッケルより硬度が高く、酸化されにくく接触抵抗が安定なためである。

[0041] 次に、上記のプロープシート枠21および周辺電極固定板9の外周部に沿って一体となったポリイミド膜84および接着層89を切り出すことで、図4Hのように、プロープカード105に取り付けられるプロープシートになる。

[0042] 次に、上記プロープシートとは製造工程が若干異なる第二の形態のプロープシートの製造方法について、図5A-5Eを参照して、その製造工程を説明する。

[0043] 図5A-5Eは、プロープシートを形成する他の製造プロセスを工程順に示したものである。

[0044] まず図4Aに示したシリコンウェハ80に角錐状のエッチング穴80aを形成し、その表面に二酸化シリコン膜82を形成し、その上に形成した導電性被覆83の表面に、接続端子部8を開口するようにホトレジストマスク85を形成する工程が実行される。

[0045] 次に、図5Bに示す上記ホトレジストマスク85をマスクとして、上記導電性被覆83を

給電層として電気めっきして、接触端子4aおよび接続電極部4bを一体として形成し、該ホトレジストマスク85を除去する工程が実行される。めっき材料として、例えば、ニッケル8a、ロジウム8b、ニッケル8cを順次にめっきして接触端子4aおよび接続電極部4bを一体として接触端子部8を形成すればよい。

- [0046] 次に、図5Cに示す工程が実行される。この工程は、上記接触端子部8および導電性被覆83を覆うようにポリイミド膜84bを形成し、上記接触端子部8からの引き出し配線接続用穴を形成すべき位置にある該ポリイミド膜84bを、上記接触端子部8の表面に至るまで除去し、該ポリイミド膜84bに導電性被覆86を形成し、ホトレジストマスク87を形成した後、配線材料88をめっきするものである。

上記ポリイミド膜84bの一部を除去するには、例えば、レーザ穴あけ加工あるいはポリイミド膜84bの表面にアルミニウムマスクを形成してドライエッチングを用いればよい。

上記導電性被覆として、例えば、クロムをスパッタリング法あるいは蒸着法により成膜することにより、厚さ $0.1\mu\text{m}$ 程度のクロム膜を形成して、該クロム膜を形成した表面に銅をスパッタリング法あるいは蒸着法により成膜することにより、厚さ $1\mu\text{m}$ 程度の銅膜を形成すればよい。また、配線材料としては、銅めっきあるいは、銅めっきにニッケルめっきをした材料を用いればよい。

- [0047] 次に、図5Dに示す工程が実行される。この工程は、上記ホトレジストマスク87を除去し、配線材料88をマスクとして導電性被覆86をエッチング除去した後、接着層89および金属膜90を接着し、ホトレジストマスクで該金属膜90をエッチングして所望の金属膜のパターンを形成するものである。

- [0048] 次に、図4E～4Gと同様な工程を経て、図5Eに示すように、プローブカード105に取り付けられるプローブシートになる。

- [0049] 第三の形態のプローブシートの製造方法について、図6A～6Gを参照して、その製造工程を説明する。

- [0050] 本プローブシートの製造方法は、初期的に選択エッチング用のめっき膜を形成する点以外は、図4A～4H、図5A～5Eで記述したプローブシートの製造方法と同様である。該選択めっき膜61は、接触端子の高さ(ポリイミド膜からの突出量)を確保するた

めに用いるものである。本製造工程では、異方性エッチングによる穴を型材として接触端子を作成する場合でも、狭ピッチかつ高密度の接触端子を維持しつつ、その高さを独立、かつ自由に調整することができます。

- [0051] 上記の選択めっき膜61を用いてプローブシートを形成する製造方法の一例について図6A-6Gを用いて次に説明する。
- [0052] まず、図6Aに示す工程が実行される。この工程は、図4A、図4Bと同様な工程で、シリコンウェハ80に角錐状のエッチング穴を形成し、その表面に二酸化シリコン膜82および導電性被覆83を形成し、図4Bとは異なり、接触端子部8を形成する部分に、ホトレジスト60あるいはドライフィルムのパターンを形成する。
- [0053] 次に、図6Bに示す工程が実行される。前記の導電性被覆83を電極として、選択めっき膜61をめっきする。選択めっき膜61としては、例えば、銅を10—50  $\mu\text{m}$ めっきする。
- [0054] 次に、図6Cに示す工程が実行される。この工程は、ホトレジスト60および選択めっき膜(銅めっき層)61の表面にクロム膜を形成し、その表面にポリイミド膜62を形成し、該ポリイミド膜62の表面にアルミニウムマスク63を形成する工程が実行される。ここで、厚さ0.1  $\mu\text{m}$ 程度のクロム膜を形成するのは、工程上でポリイミドとの接着性を確保するためであり、クロム膜を省略することも可能である。
- [0055] 次に、図6Dに示す工程が実行される。この工程は、前記ポリイミド膜62の表面に形成したアルミニウムマスク63により、レーザあるいはドライエッチでポリイミド膜62およびホトレジスト60を、接触端子部8を形成する部分に対応する部分を除去する工程が実行される。
- [0056] 次に、図6Eに示す工程が実行される。この工程は、前記アルミニウムマスク63を除去して、導電性被覆83および選択めっき膜61を電極として、硬度の高い材料を主成分として電気めっきして、接触端子4aおよび接続電極部4bを一体として形成するものである。硬度の高いめっき材料として、例えば、ニッケル8a、ロジウム8b、ニッケル8cを順次にめっきして接触端子4aおよび接続電極部4bを一体として接触端子部8を形成すればよい。
- [0057] 次に、図4C—図4Dと同様な工程で、図6Fに示した引き出し配線88および所望の

金属膜30のパターンを形成する。

- [0058] 次に、図4Eー図4Gと同様な工程で、図6Gに示したプローブシートを形成する。
- [0059] 第四の形態のプローブシートの製造方法について、図7Aー7E2を参照して、その製造工程を説明する。
- [0060] 本プローブシートの製造方法は、接触端子の高さ(ポリイミド膜からの突出量)を確保するため、図6Aー6Gと同様に初期的に選択エッチング用のめっき膜を形成する点以外は、図4Aー4H、図5Aー5Eで記述したプローブシートの製造方法と同様である。図6Aー6Gで示した工程と異なる点は、接触端子部8を形成する部分に形成したホトレジスト60を除去して、ポリイミドで接触端子部も一体的に充填する製法とする点である。
- [0061] 上記の選択めっき膜61を用いてプローブシートを形成する製造方法の一例について図7Aー7E2を用いて次に説明する。
- [0062] まず、図7Aに示す工程が実行される。この工程は、図6A、図6Bと同様な工程で、シリコンウェハ80に角錐状のエッチング穴を形成し、その表面に二酸化シリコン膜82および導電性被覆83を形成し、接触端子部8を形成する部分に、ホトレジスト60あるいはドライフィルムのパターンを形成し、該導電性被覆83を電極として、選択めっき膜61をめっきする。その後、ホトレジスト60を上記導電性被覆83の表面に至るまですべて除去して、その後、クロム膜64を形成し、ポリイミド62aで接触端子部も一体的に充填したポリイミド膜を形成する。この場合、クロム膜を省略することも可能である。
- [0063] 次に、図6Dー図6Gと同様な工程で、図6Gに示したプローブシートを形成する。
- [0064] なお、図7Cおよび図7Dに示したように、金属膜をマスクとして、ポリイミド接着層およびポリイミド膜をレーザあるいはドライエッチング等で接触端子部周辺を除去して、金属膜で補強され、接触端子部が配線材料で支持された両持ち梁あるいは、図7Eに示したように、片持ち梁を形成してもよい。  
これらの両持ち梁あるいは、片持ち梁構造により、接触端子の接触面の高さばらつき吸収量が大きくできる。これらの両持ち梁あるいは片持ち梁の構造は、他のプローブシートの製造法でも同様に形成してもよいことはいうまでもない。
- [0065] 第5の形態のプローブシートの製造方法について、図8Aー8Dを参照して、その製

造工程を説明する。

- [0066] 本プローブシートの製造方法は、ホトレジスト65を用いて接触端子部8を形成し、一旦、該ホトレジスト65を除去して接触端子部8を露出し、ポリイミド膜84bで覆った後、ポリイミド膜84bの一部を除去して引き出し配線88を形成する点以外は、図6A—6Gで記述したプローブシートの製造方法と同様である。
- [0067] 上記の製造方法の一例について図8A—8Dを用いて次に説明する。
- [0068] まず、図8Aに示す工程が実行される。この工程は、図6A—図6Eと同様な工程で、選択めっき膜61表面のホトレジスト65のパターンを用いて、シリコンウェハ80に形成した角錐状のエッチング穴を型材として、接触端子部8を形成する。ここで図6cのポリイミド膜62あるいは図7Bのポリイミド膜62aにかえて、除去が容易なホトレジスト65を用いることが望ましい。
- [0069] 次に、図8Bに示す工程が実行される。この工程は前記のホトレジスト65を除去して、接触端子部8のシリコンウェハ80の反対面を露出し、ポリイミド膜84bで覆った後、アルミニウムマスク63aを形成するものである。
- [0070] 次に、図8Cに示す工程が実行される。この工程は前記アルミニウムマスク63aを用いて引き出し配線88と接続する部分のポリイミド膜84bを接触端子部8の表面に至るまで除去し、その後、図6Fと同様の工程で、引き出し配線および接着層89および金属膜30のパターンを形成するものである。
- [0071] 次に、図4E—図4Gと同様な工程で、図8Dに示したプローブシートを形成する。
- [0072] 以上、プローブシートの製造方法について幾つか述べたが、その工程は必要に応じて適宜組合せ可能である。
- [0073] なお、高速電気信号検査用のプローブとして電気信号の乱れを極力防止するためには、プローブシートの表面(両表面あるいは一方の面)あるいは、グランド層を挟んだプローブシート構造とすればよい。例えば、金属膜のパターンを形成した面に導電材料のスパッタ膜を形成する。スパッタ膜材料としては、クロム、チタン、銅、金、ニッケルなどを単独、あるいは組み合わせて用いればよい。
- [0074] また、金属膜30を可能な限り残して、グランド層70として利用することも可能である。また、図9に示したように、銅膜を引き出し配線20の上の接着層89と金属膜30との

間に多層膜として形成し、グランド層70として用いてもよい。また、図10に示したように、例えば、図4Fの直後にシリコンウェハ80をエッチング除去して、表面に導電性被覆83が露出した段階で、ホトレジストマスクを形成して導電性被覆83でグランド層70を形成することも可能である。

- [0075] 以上、プローブシートのグランド層の形成方法については、前述の図4Aー図8Dのどの製法のプローブカードにも適用できることは言うまでもない。
- [0076] より高速の電気信号検査を可能にするために、接触端子の近傍に、電気信号の乱れを防止する目的で、コンデンサあるいは抵抗器などの搭載部品72を設置するためのプローブシート6の一例を、図14A、14Bに示した。図14Aにグランド層70および電源層71をシート状にして、逐次積層形成したプローブシート6に搭載部品72を接続した断面図、図14Bに、プローブシート6表面に搭載部品72を接続した平面概略図を示した。例えば、図14Bのような状態でプローブシート6に搭載部品72を接続する場合は、グランド用および電源用配線の配線幅を可能な限り広くして配線抵抗値を下げ、グランド配線と電源配線が隣同士(ペア線)になるように配置し、各々の配線に搭載する部品の接続用電極となる部分の絶縁層を、レーザあるいはドライエッチングなどの穴あけ加工技術を用いて穴あけ加工して、ビア形成用穴72aを設け、その穴に、はんだあるいはめっきなどの導電材料72bを充填して、はんだ接合あるいは金属拡散接合などで搭載部品72をプローブシート6に接合すればよい。
- [0077] プローブシート6の周辺電極5の群を、多層配線基板50の表面に形成した電極群50aに導通させるための該周辺電極群50のパターンおよびそれに対応する多層配線基板50の該電極群50aのパターンの一例を、図15に示した。
- [0078] プローブシート6の配線20および周辺電極5は、例えば、図4Aー図8Dの製造プロセスによる薄膜配線形成により、ポリイミドシートの一方の面に接触端子が突出した形で形成され、ポリイミド内部に配線20が形成される。そのため、配線20がポリイミドで覆われるため、多層配線基板50の表面に形成した電極群50aに配線20が接触することがなく、短絡することがない構成である。このプローブシート6の周辺電極5の群を、スルーホールビア50dで多層配線基板50の内部配線50bに接続された電極群50aに、前述したノックピン34を用いて位置決めして、緩衝材31を挟んで周辺押さえ板

で押さえ込むことにより、両電極を圧接する。

- [0079] ここで、個別の電極50aに対して、プロープシート6の周辺電極5を複数個形成するのは、接触面の異常や異物、凹凸などによる接触不良の可能性を少なくして、安定した接触を確保するためである。個々の周辺電極5に複数個の接触端子を設けるのは、電極の寸法に余裕がある場合に形成すればよいのであり、1個であってもよいことは、いうまでもない。
- [0080] ここで、図4Aー図8Dの製造プロセスによるプロープシート6を形成する場合、周辺電極5を角錐形状あるいは角錐台形状等の接触端子とすることができますため、従来の半球状めっきバンプや平面電極同士の接触と比較して、硬度のある接触端子で低接触圧で安定した接触特性値が実現でき、また、ホトリソ工程で形成するため、先端位置精度が良好な接続を実現できる。上記理由により先端位置精度が良好であることから、位置決め用孔による位置合わせだけで、多層配線基板50の電極群50aとの正確な接続が容易に実現できる。なによりも、多層配線基板の電極群50aに接続するための周辺電極5を、ウェハ電極接続用の接触端子4と共に同一面側に一括形成することができ、効率的である。
- [0081] 次に、以上説明した本発明に係るプロープカードを用いた半導体検査装置について図11を用いて説明する。
- [0082] 図11は、本発明に係る半導体検査装置を含む検査システムの全体構成を示す図である。図11は、所望の荷重をウェハ1の面に加えて電気特性検査を実施する試験装置を示す。この状態では、スプリングプロープ12の荷重が全接触端子に加わり、ウェハ1の電極3に接触した接触端子4、引き出し配線20、周辺電極5、配線基板50の電極50a、内部配線50b、接続端子50cを通じて半導体素子の電気的特性の検査を行うテスタ(図示せず)との間で検査用電気信号の送受信が実施される。
- [0083] 検査システムの全体構成において、プロープカードはウェハプローバとして構成されている。この検査システムは、被検査対象である半導体ウェハ1を支持する試料支持系160と、被検査対象(ウェハ)1の電極3に接触して電気信号の授受を行うプロープカード120と、試料支持系160の動作を制御する駆動制御系150と、被検査対象1の温度制御を行う温度制御系140と、半導体素子(チップ)2の電気的特性の検査

を行うテスタ170とで構成される。この半導体ウエハ1は、多数の半導体素子(チップ)が配列され、各半導体素子の表面には、外部接続電極としての複数の電極3が配列されている。試料支持系160は、半導体ウエハ1を着脱自在に載置してほぼ水平に設けられた試料台162と、この試料台162を支持するように垂直に配置される昇降軸164と、この昇降軸164を昇降駆動する昇降駆動部165と、この昇降駆動部165を支持するX-Yステージ167とで構成される。X-Yステージ167は、筐体166の上に固定される。昇降駆動部165は、例えば、ステッピングモータなどから構成される。試料台162の水平および垂直方向における位置決め動作は、X-Yステージ167の水平面内における移動動作と、昇降駆動部165による上下動などを組み合わせることにより行われる。また、試料台162には、図示しない回動機構が設けられており、水平面内における試料台162の回動変位が可能にされている。

- [0084] 試料台162の上方には、プローブ系120が配置される。すなわち、例えば、図2A、2Bに示すプローブカード120および多層配線基板50は、当該試料台162に平行に対向する姿勢で設けられる。各々の接触端子4は、該プローブカード120のプロープシート6に設けられた引き出し配線20、周辺電極5を介して、多層配線基板50の電極50aおよび内部配線50bとを通して、該配線基板50に設けられた接続端子50cに接続され、該接続端子50cに接続されるケーブル171を介して、テスタ170と接続される。
- [0085] ここで、ヒータにより所望の温度に加熱されたウエハと該ウエハへの電極に接触して電気信号検査を実施するための接触端子を形成したプロープシートの温度差による位置ずれを防止し、位置合わせを精確にしかも短時間に実施するため、プロープシートあるいはプロープカードの表面あるいは内部にあらかじめ温度制御の可能な発熱体を形成してもよい。発熱体としては、例えば、Ni-Crのような抵抗値の高い金属材料や高抵抗の導電樹脂を直接プロープシートあるいは多層配線基板層に形成したり、該材料を形成したシートをプロープシートにはさんだり、プロープカードに貼り付けてもよい。また、発熱体として暖めた液体をヒートブロック内のチューブに流して該ヒートブロックをプロープカードに接触させててもよい。

- [0086] 加熱されたウエハからの熱放射と、プローピング時の接触からプロープカードの温度が決まる従来方法と異なり、上記のようにプロープシートを独立して検査時の温度に保っておくことにより、ウエハとプロープシート間の検査時の温度差の発生を防止することができ、位置精度の精確なプローピングが可能となる。
- [0087] 駆動制御系150は、ケーブル172を介してテスタ170と接続される。また、駆動制御系150は、試料支持系160の各駆動部のアクチュエータに制御信号を送って、その動作を制御する。すなわち、駆動制御系150は、内部にコンピュータを備え、ケーブル172を介して伝達されるテスタ170のテスト動作の進行情報に合わせて、試料支持系160の動作を制御する。また、駆動制御系150は、操作部151を備え、駆動制御に関する各種指示の入力の受付、例えば、手動操作の指示を受け付ける。
- [0088] 試料台162には、半導体素子2を加熱させるためのヒータ141が備えられている。温度制御系140は、試料台162のヒータ141あるいは冷却治具を制御することにより、試料台162に搭載された半導体ウエハ1の温度を制御する。また、温度制御系140は、操作部151を備え、温度制御に関する各種指示の入力の受付、例えば、手動操作の指示を受け付ける。ここで、上記プロープシートあるいはプロープカードの一部に設けた温度制御の可能な発熱体と試料台162のヒータ141とを連動させて温度制御してもよい。
- [0089] 以下、半導体検査装置の動作について説明する。まず、被検査対象である半導体ウエハ1は、試料台162の上に位置決めして載置され、X-Yステージ167および回動機構を駆動制御し、半導体ウエハ1上に配列された複数個の半導体素子上に形成された電極3の群を、プロープカード120に並設された多数の接触端子4の直下に位置決めする。その後、駆動制御系150は、昇降駆動部165を作動させて、多数の電極(被接触材)3の全体の面が接触端子4の先端に接触した時点から30ー100 μm程度押し上げる状態になるまで試料台162を上昇させることによって、プロープシート6において多数の接触端子4が並設された領域部4aを張り出させて平坦度を高精度に確保された多数の接触端子4における各々の先端を、コンプライアンス機構(押圧機構)により半導体素子に配列された多数の電極3の群(全体)の面に追従するように倣って平行出しすることによって半導体ウエハ1上に配列された各被接触材(電

極)3に倣って均一な荷重(1ピン当たり3~150mN程度)に基づく押し込みによる接觸が行われ、各接触端子4と各電極3との間において低抵抗(0.01Ω~0.1Ω)で接続されることになる。

- [0090] さらに、ケーブル171、配線基板50、および接触端子4を介して、半導体ウエハ1に形成された半導体素子とテスタ170との間で、動作電流や動作検査信号などの授受を行い、当該半導体素子の動作特性の可否などを判別する。さらに、上記の一連の検査動作が、半導体ウエハ1に形成された複数の半導体素子の各々について実施され、動作特性の可否などが判別される。
- [0091] 最後に、上記半導体検査装置を用いた検査工程、又は検査方法を含む、半導体装置の製造方法について図12を参照して説明する。
- [0092] 本発明に係る半導体装置の製造方法は、ウエハに回路を作りこみ、半導体素子を形成する工程と、本発明に係る半導体検査装置によりウエハレベルで複数の半導体素子2の電気的特性を一括して検査する工程と、該ウエハをダイシングし、半導体素子ごとに分離する工程と、該半導体素子を樹脂等で封止する工程を有するものである。
- [0093] 本発明に係る他の半導体装置の製造方法は、ウエハに回路を作りこみ、半導体素子を形成する工程と、本発明に係る半導体検査装置によりウエハレベルで複数の半導体素子2の電気的特性を一括して検査する工程と、該ウエハをダイシングし、半導体素子ごとに分離する工程を有するものである。
- [0094] 本発明に係る他の半導体装置の製造方法は、ウエハに回路を作りこみ、半導体素子を形成する工程と、該ウエハを樹脂等で封止する工程と、該封止されたウエハに形成された複数の半導体素子2の電気的特性を本発明に係る半導体検査装置により一括して検査する工程を有するものである。
- [0095] 本発明に係る他の半導体装置の製造方法は、ウエハに回路を作りこみ、半導体素子を形成する工程と、該ウエハを樹脂等で封止する工程と、該封止されたウエハに形成された複数の半導体素子2の電気的特性を本発明に係る半導体検査装置により一括して検査する工程と、該ウエハをダイシングし、半導体素子ごとに分離する工程を有するものである。

- [0096] 上記した半導体装置の製造方法における該半導体素子2の電気的特性を検査する工程では、本願で開示したプローブカードを用いることにより、位置精度よく良好な接触特性を得ることができる。
- [0097] すなわち、結晶性を有する基板の異方性エッチングによる穴を型材としてめつきすることで形成される角錐形状又は角錐台形状の接触端子4を用いて検査することにより、低接触圧で安定した接触特性を実現でき、下部にある半導体素子を傷めずに検査することが可能である。また、複数の接触端子4が金属膜30aで取り囲まれる構造をとるため、検査動作時でも該接触端子は余分な応力を受けず、該半導体素子2の電極との精確な接触が実現できる。複数個の半導体素子2を一括で検査することも可能になる。
- [0098] さらに、半導体素子2の電極への圧痕は、小さく、しかも点(角錐形状又は角錐台形状に穴があいた点)になるため、該電極表面には圧痕のない平らな領域が残ることになり、図12に示すように接触による検査が複数回あっても対応できる。
- [0099] 以上、本発明者によってなされた発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。
- [0100] 本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記のとおりである。
- [0101] (1)接触端子の先端位置精度を確保し、狭ピッチの電極構造を有する半導体素子を確実に検査できる検査装置を提供することができる。
- [0102] (2)電極への良好な接続を確保し、信頼性を向上させた半導体装置の製造方法を提供することができる。

#### 図面の簡単な説明

- [0103] [図1]Aは、半導体素子(チップ)が配列された被接触対象であるウエハを示す斜視図であり、Bは、該ウエハ内の半導体素子(チップ)を示す斜視図である。
- [図2]Aは、本発明に係るプローブカードの第一実施例の要部を示す断面図であり、Bは、Aの主要部品を分解して図示した斜視図である。
- [図3]Aは、本発明に係るプローブカードの第二実施例の要部を示す断面図であり、

Bは、Aの主要部品を分解して図示した斜視図である。

[図4]AからHは、本発明に係るプロープカードにおけるプロープシート部分を形成する製造プロセスを工程順に示したものである。

[図5]AからEは、本発明に係るプロープカードにおけるプロープシートを形成する他の製造プロセスを工程順に示したものである。

[図6]AからGは、本発明に係るプロープカードにおけるプロープシートを形成する他の製造プロセスを工程順に示したものである。

[図7]AからCは、本発明に係るプロープカードにおけるプロープシートを形成する他の製造プロセスを工程順に示したものであり、D1およびE1は、それぞれ本発明に係るプロープカードにおけるプロープシートの接触端子部を形成した領域の一部概略断面図を示したものであり、D2は、D1の接触端子部を形成した領域の一部を、D1の下面から見た平面図であり、E2は、E1の接触端子部を形成した領域の一部を、E1の下面から見た平面図である。

[図8]AからDは、本発明に係るプロープカードにおけるプロープシートを形成する他の製造プロセスを工程順に示したものである。

[図9]本発明に係るプロープカードにおけるグランド層を形成したプロープシートの概略断面図を示したものである。

[図10]本発明に係るプロープカードにおけるグランド層を形成した他のプロープシートの概略断面図を示したものである。

[図11]本発明に係る検査システムの一実施の形態を示す全体概略構成を示す図である。

[図12]半導体装置の検査工程の一実施例を示す工程図である。

[図13]本発明に係るプロープカードの組み立て方法を示す概略図である。

[図14]Aは、本発明に係るプロープカードの一実施例の要部を示す断面図であり、Bは、Aの部品搭載部分の配線を拡大して図示した平面概略図である。

[図15]本発明に係る多層配線基板表面の周辺電極パターンおよびプロープシートの配線パターンの一例を示したものである。

## 請求の範囲

- [1] プローブカードは、  
被検査対象に設けられた電極と接触する複数の接触端子と、  
該接触端子各々から引き出された配線と、  
該配線と電気的に接続され、かつ多層配線基板の電極に接続される複数の周辺  
電極とを備え、  
該多層配線基板の電極と該配線とは、周辺電極を介して電気的に接続されている  
。
- [2] 請求項1に記載のプローブカードであって、  
該接触端子及び周辺電極は、角錐形状又は角錐台形状である。
- [3] 請求項1記載のプローブカードであって、  
該複数の周辺電極及び該多層配線基板の電極は、格子状に配置されている。
- [4] 請求項1に記載のプローブカードであって、  
該接触端子及び該周辺電極は、結晶性を有する基板の異方性エッチングによる穴  
を型材として形成されたものである。
- [5] プローブカードは、  
被検査対象の電気的特性を検査するテスタと電気的に接続される多層配線基板と  
、  
該多層配線基板の電極に接続される複数の周辺電極と被検査対象に設けられた  
電極と接触する複数の接触端子とを有するプローブシートとを備え、  
該プローブシートは、さらに、該複数の接触端子を取り囲むように形成された第1の  
金属膜と、該第1の金属膜を取り囲むように形成された第2の金属膜とを有する。
- [6] 請求項5に記載のプローブカードであって、  
該接触端子及び周辺電極は、角錐形状又は角錐台形状である。
- [7] 請求項5に記載のプローブカードであって、  
該第1の金属膜と該第2の金属膜とは該複数の接触端子と該複数の周辺電極との  
間に形成されている。
- [8] 請求項5に記載のプローブカードであって、

該第1の金属膜と該第2の金属膜との間の領域は、該プローブシートの該第1の金属膜又は該第2の金属膜が形成された領域よりも柔軟性を有する。

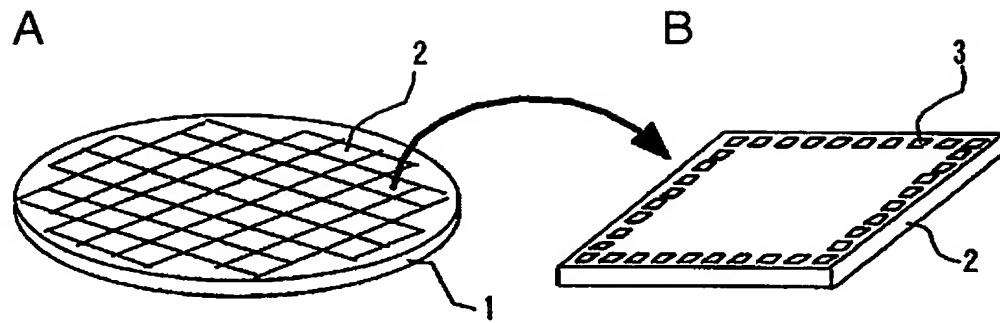
- [9] 請求項5に記載のプローブカードであって、  
該第1の金属膜の外周は、円状に形成される。
- [10] 請求項5に記載のプローブカードであって、該プローブシートはさらに、  
該複数の周辺電極を取り囲むように形成された第3の金属膜を備え、該第3の金属膜には位置決め用の孔が設けられている。
- [11] 請求項5に記載のプローブカードであって、該プローブシートはさらに、  
該配線と電気的に接続されるグランド層及び電源層を備え、  
該グランド層又は該電源層に接続される配線は、該グランド層と該電源層のいずれにも接続されない配線よりも、配線幅が広く形成されている。
- [12] 請求項5に記載のプローブカードであって、  
該プローブシートは、さらに、該複数の周辺電極を取り囲むように形成され、かつ位置決め用の孔が設けられた第3の金属膜を有し、  
該多層配線基板は、さらに、位置決め用の孔を有し、  
該複数の周辺電極と該多層配線基板の電極との接続は、該第3の金属膜に設けられた位置決め用の孔及び該多層配線基板に設けられた位置決め用の孔を通るノックピンを挿入することにより位置合わせしている。
- [13] 請求項12記載のプローブカードであって、  
該複数の周辺電極及び該多層配線基板の電極は、格子状に配置されている。
- [14] 請求項5に記載のプローブカードであって、  
該接触端子及び該周辺電極は、結晶性を有する基板の異方性エッチングによる穴を型材として形成されたものである。
- [15] 請求項5に記載のプローブカードであって、更に、  
該プローブシートの該複数の接触端子が形成された領域に押し付け力を付与する手段を備え、  
該押し付け力を付与する手段は、該第2の金属膜が形成された領域に対して該第1の金属膜が形成された領域及び該複数の接触端子が形成された領域が傾動可能

になるように、配置されている。

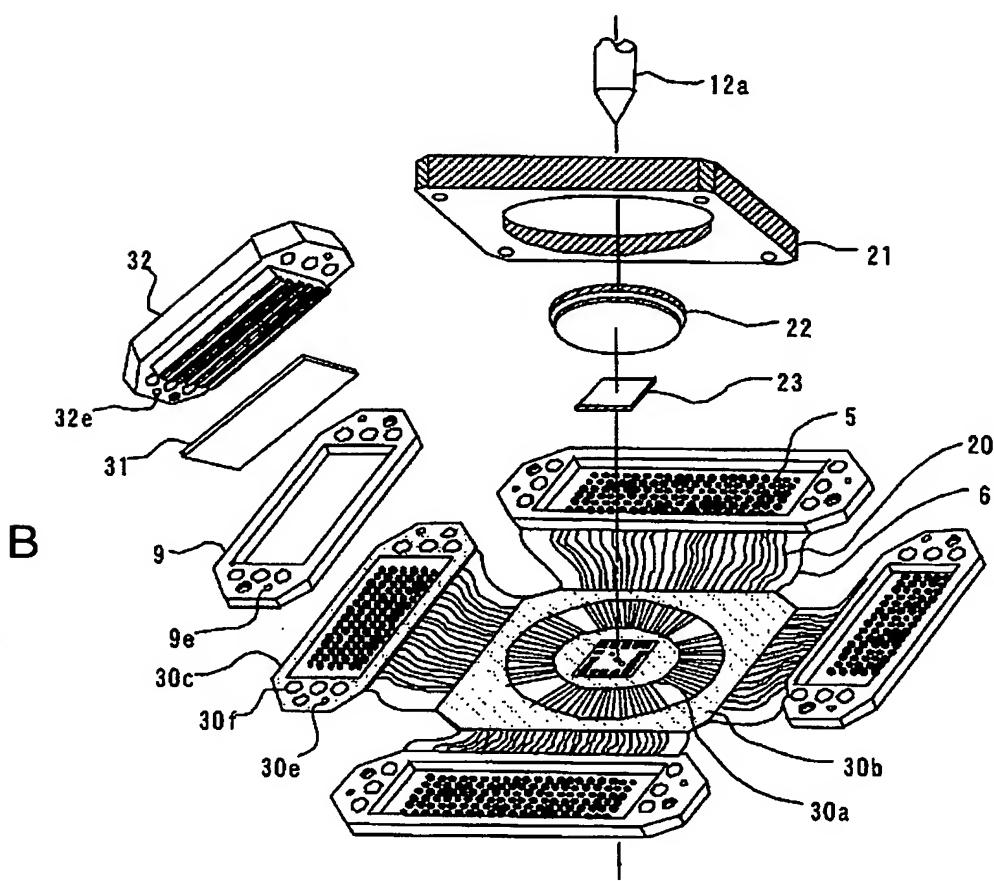
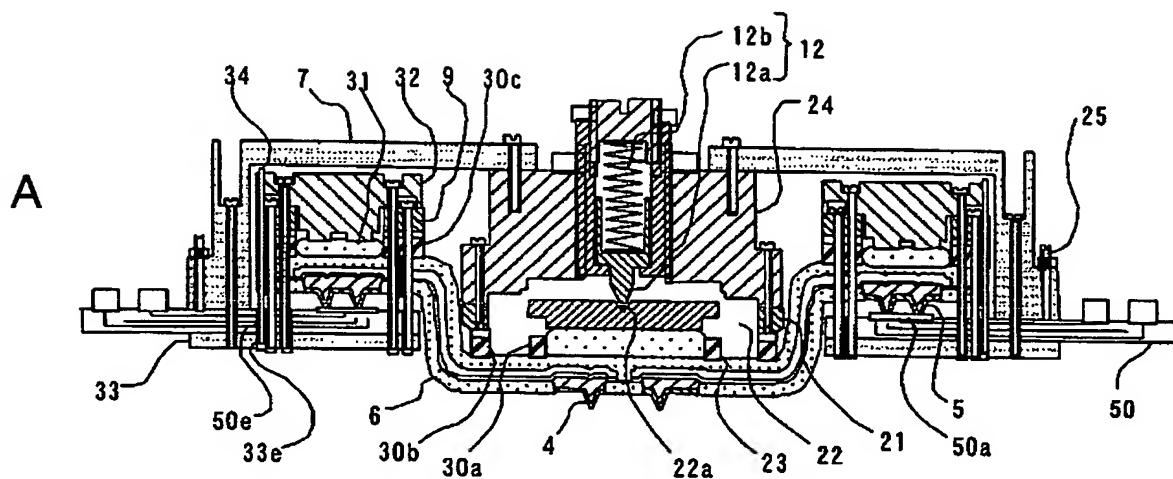
- [16] 半導体検査装置は、  
被検査対象を載せる試料台と、  
該被検査対象に設けられた電極と接触する複数の接触端子を有し、かつ該被検査対象の電気的特性を検査するテスタと電気的に接続されるプローブカードとを備え、  
該プローブカードは、更に、  
該接触端子各々から引き出された配線と、  
該配線と電気的に接続され、かつ多層配線基板の電極に接続される複数の周辺電極とを備え、  
該多層配線基板の電極と該配線とは、角錐形状又は角錐台形状の周辺電極を介して電気的に接続されている。
- [17] 半導体装置の製造方法は、  
ウエハに回路を作りこみ、半導体素子を形成する工程と、  
該半導体素子の電気的特性を検査する工程と、  
該ウエハをダイシングし、該半導体素子ごとに分離する工程とを備え、  
該半導体素子の電気的特性を検査する工程では、  
該半導体素子の電極に接触する複数の接触端子と、該複数の接触端子を取り囲むように形成された第1の金属膜と、該第1の金属膜を取り囲むように形成された第2の金属膜とを有するプローブシートを用い、  
該プローブシートの該第1の金属膜が形成された領域及び該複数の接触端子が形成された領域に押し付け力を付与しつつ、該複数の接触端子を該半導体素子に設けられた電極に接触させて検査する。
- [18] 請求項17に記載の半導体装置の製造方法であって、  
該複数の接触端子は、角錐形状又は角錐台形状である。
- [19] 請求項17に記載の半導体装置の製造方法であって、  
該複数の接触端子は、結晶性を有する基板の異方性エッチングによる穴を型材として形成されたものである。
- [20] 半導体装置の製造方法は、

- ウエハに回路を作りこみ、半導体素子を形成する工程と、  
該半導体素子の電気的特性を検査する工程と、  
該ウエハをダイシングし、該半導体素子ごとに分離する工程と  
を備え、  
該半導体素子の電気的特性を検査する工程では、  
該半導体素子の電極に接触する複数の接触端子、該複数の接触端子を取り囲む  
ように形成された第1の金属膜、及び該第1の金属膜を取り囲むように形成された第2  
の金属膜とを有するプローブシートと、を有するプローブカードを用いて、  
該複数の接触端子を該半導体素子に設けられた電極に接触させて検査する。
- [21] 請求項20に記載の半導体装置の製造方法であって、  
該プローブカードは更に、該プローブシートの該第1の金属膜が形成された領域及  
び該複数の接触端子が形成された領域に押し付け力を付与する手段を有し、  
該半導体素子の電気的特性を検査する工程では、  
該プローブシートの該第1の金属膜が形成された領域及び該複数の接触端子が形  
成された領域に該押し付け力を付与する手段により押し付け力を付与しつつ、該複  
数の接触端子を該半導体素子に設けられた電極に接触させて検査する。
- [22] 請求項20に記載の半導体装置の製造方法であって、  
該複数の接触端子は、角錐形状又は角錐台形状である。
- [23] 請求項20に記載の半導体装置の製造方法であって、  
該複数の接触端子は、結晶性を有する基板の異方性エッチングによる穴を型材と  
して形成されたものである。

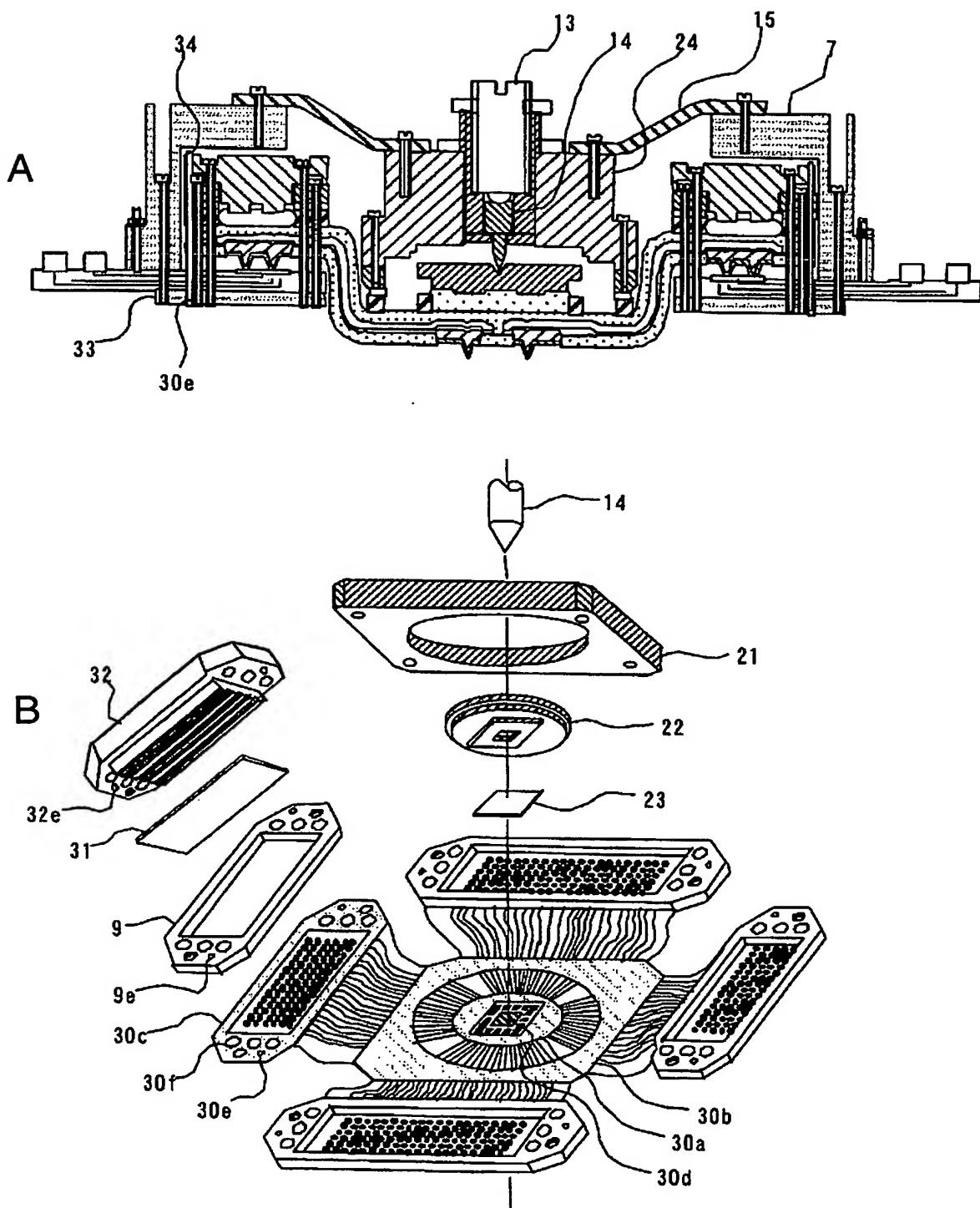
[図1]



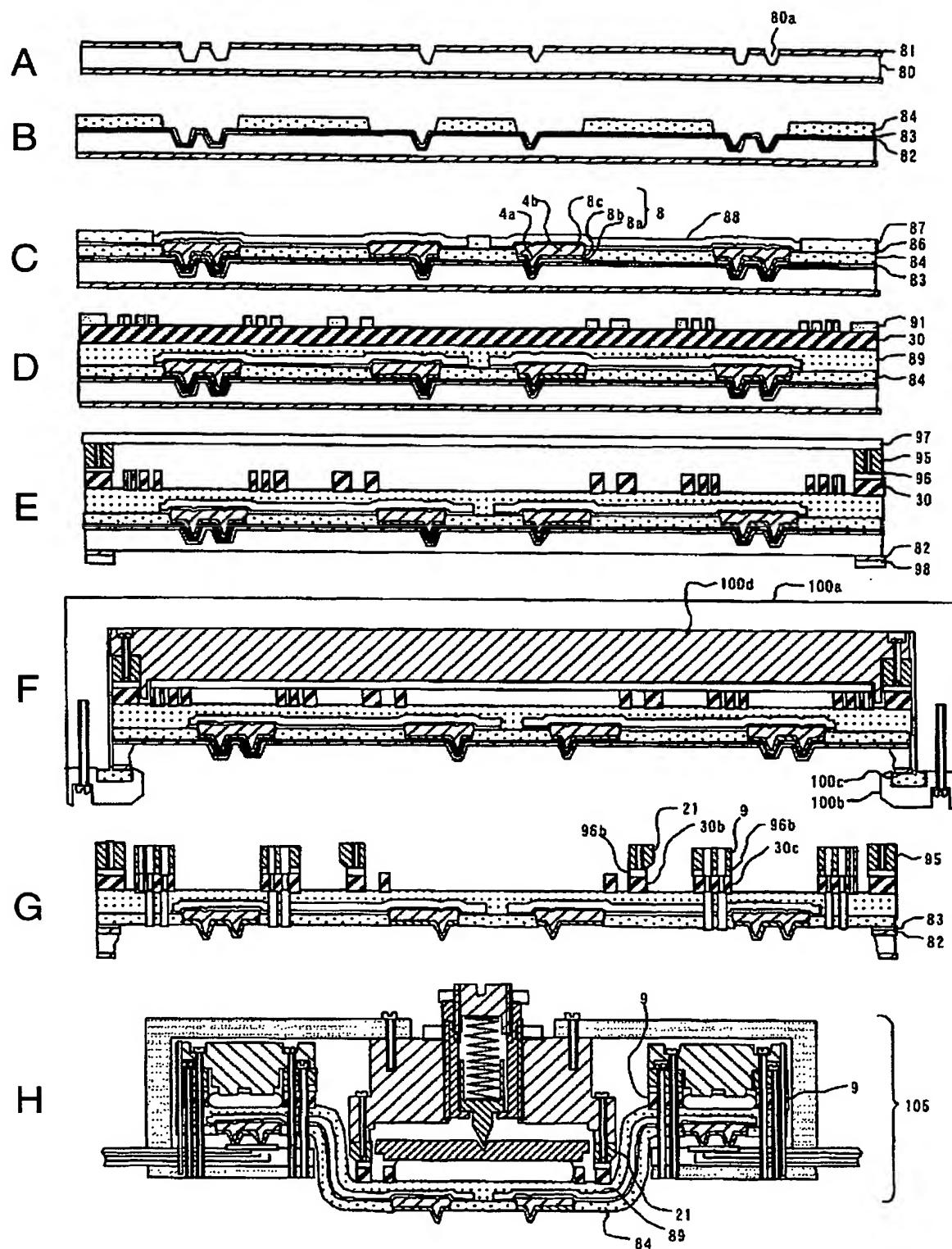
[図2]



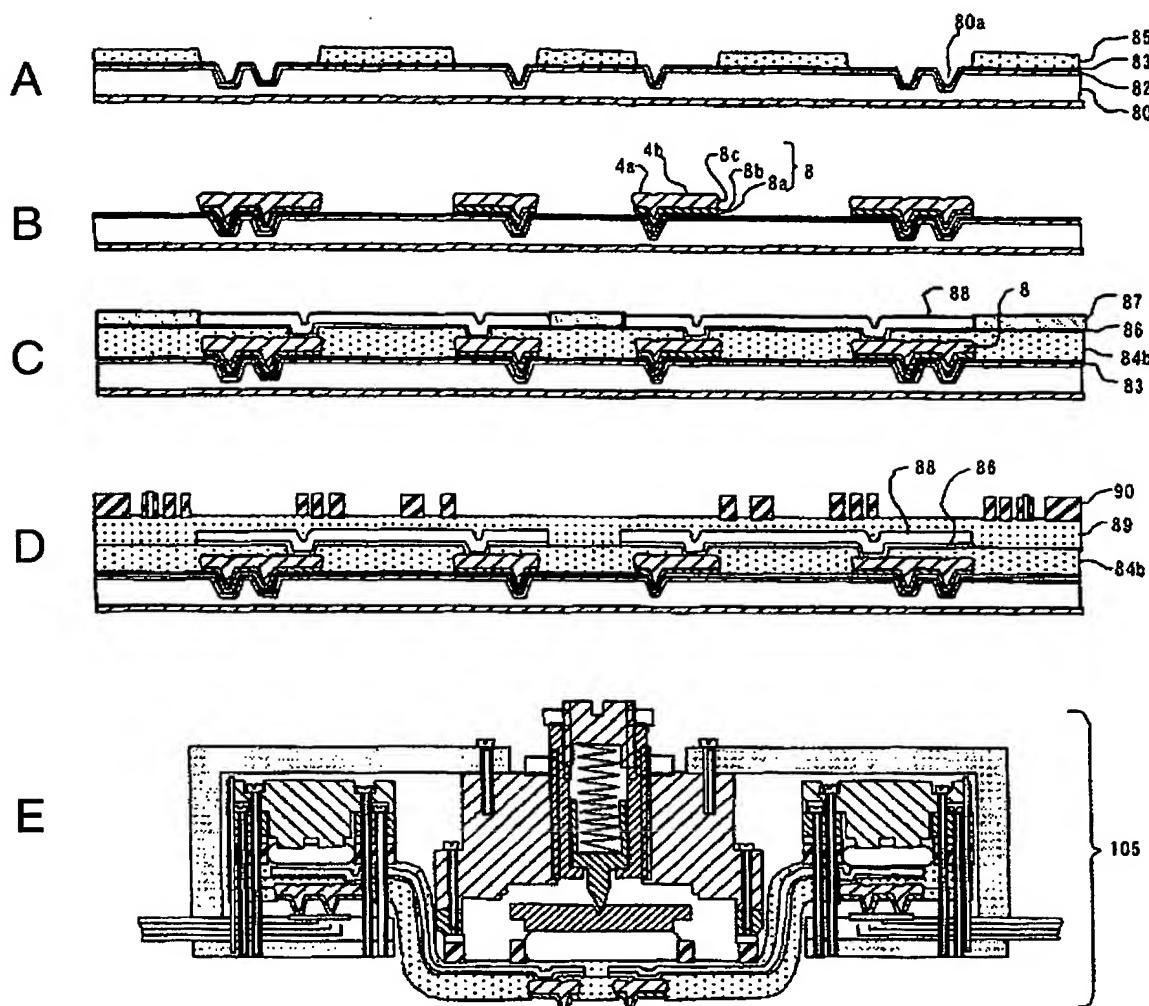
[図3]



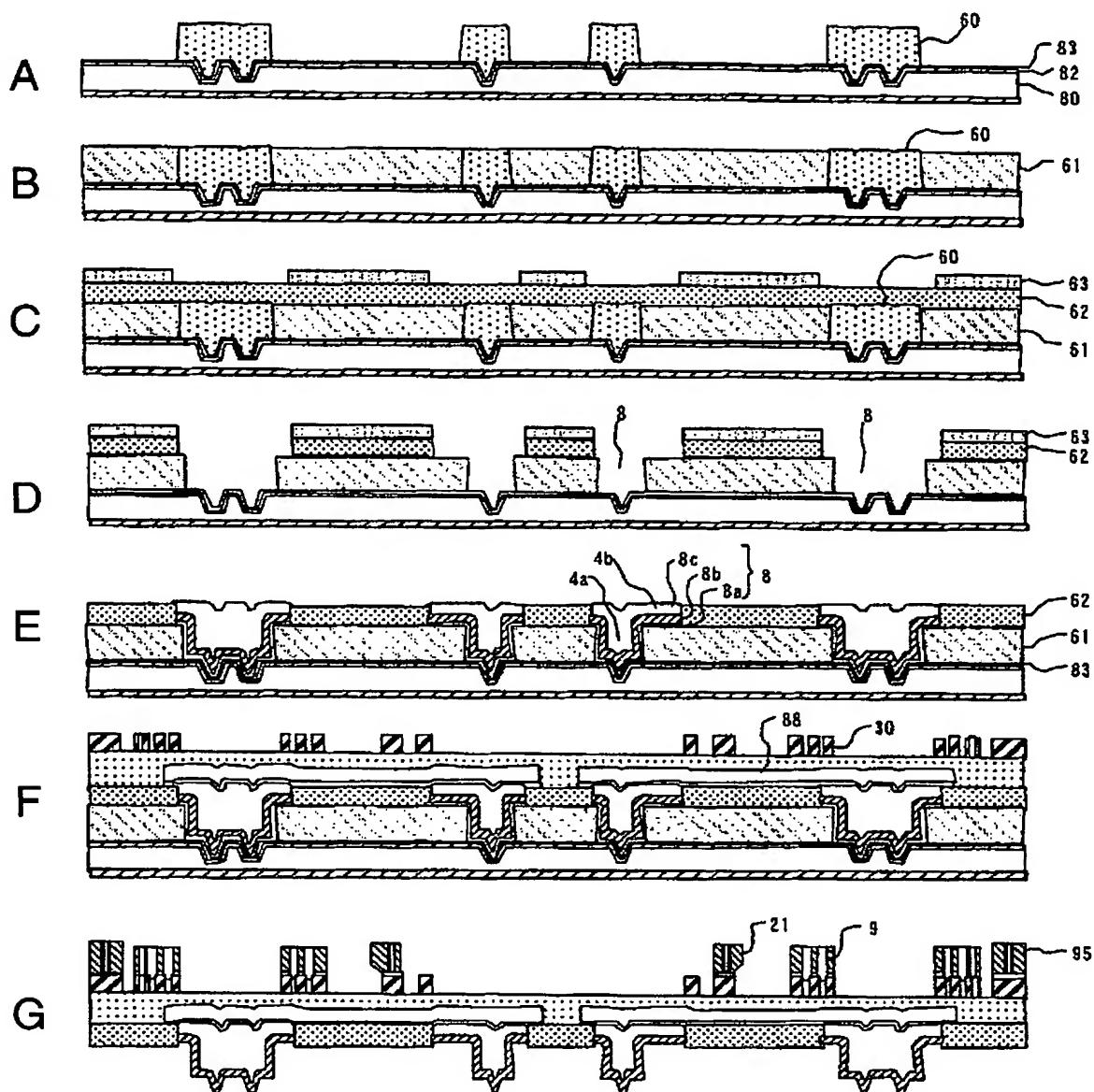
[図4]



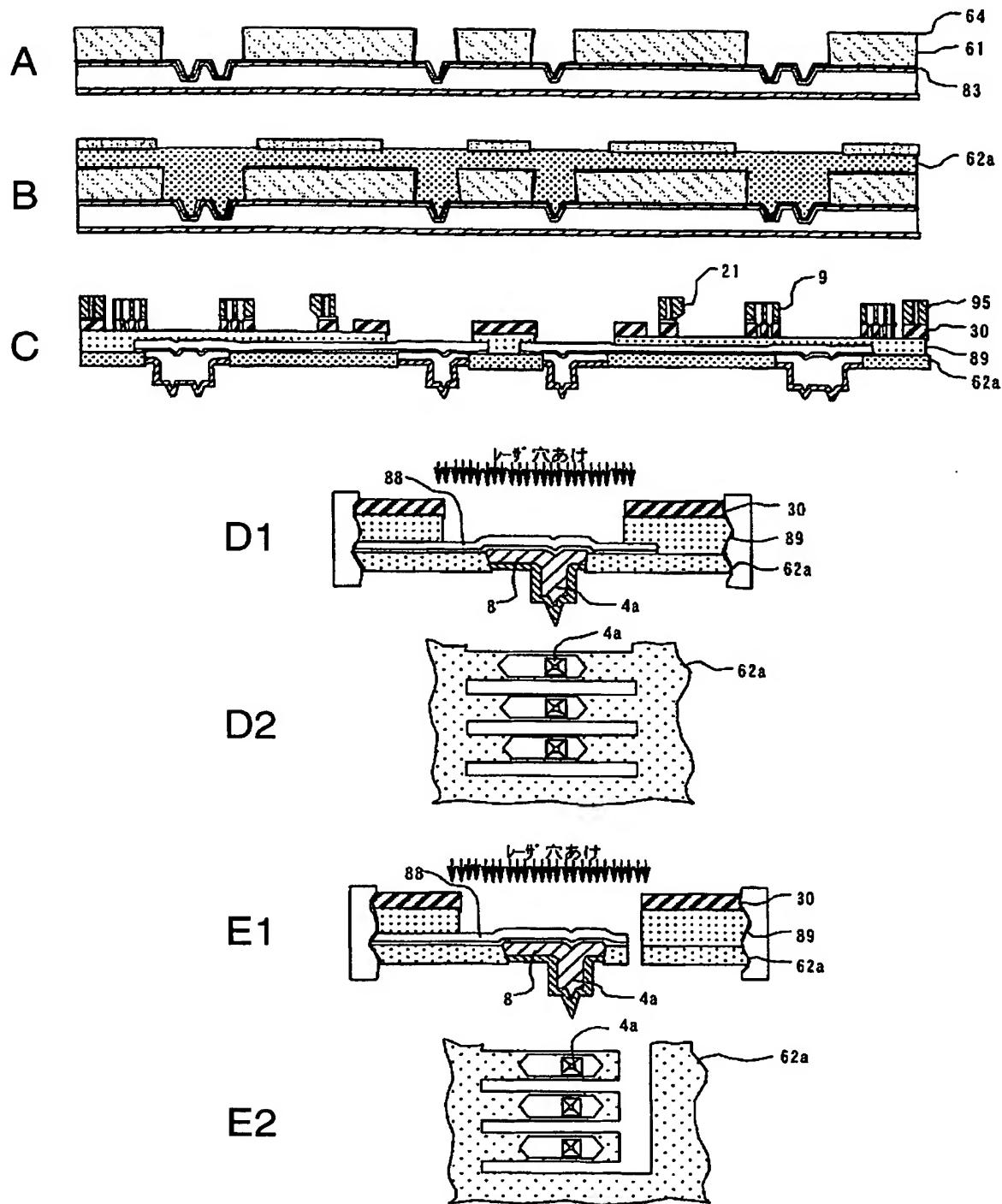
[図5]



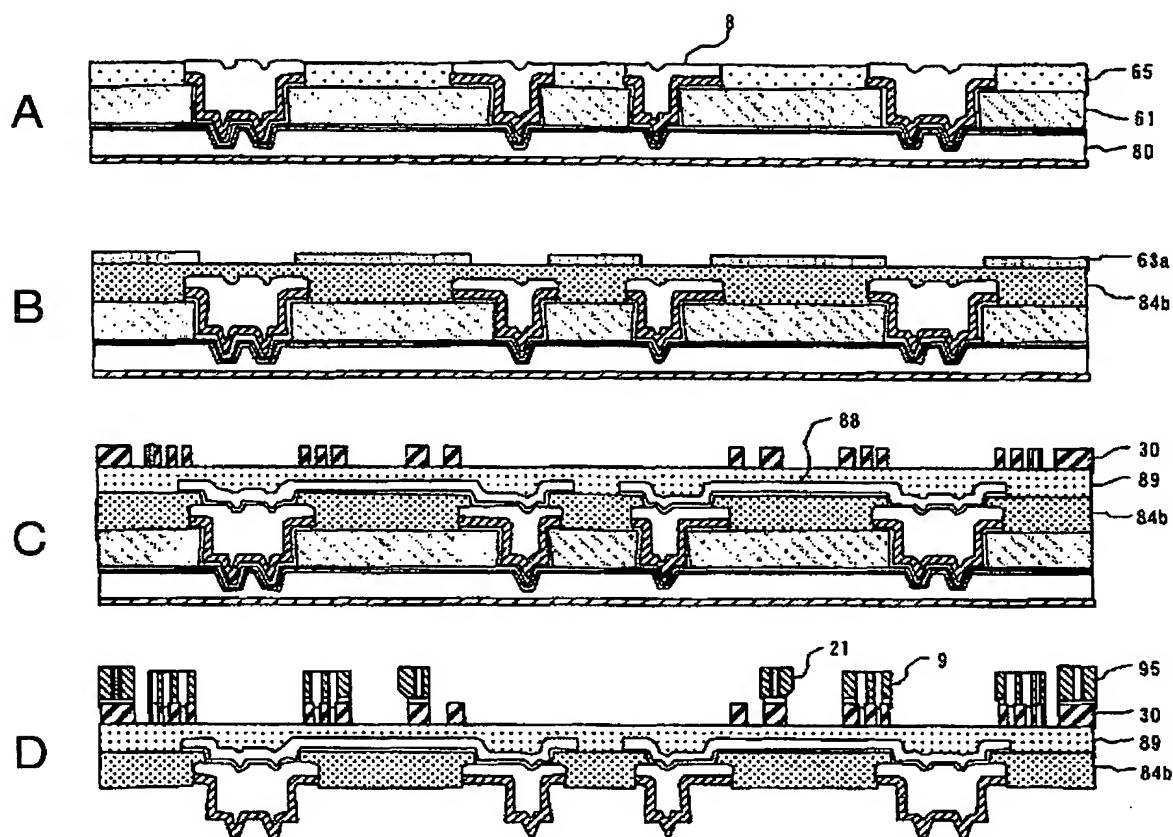
[図6]



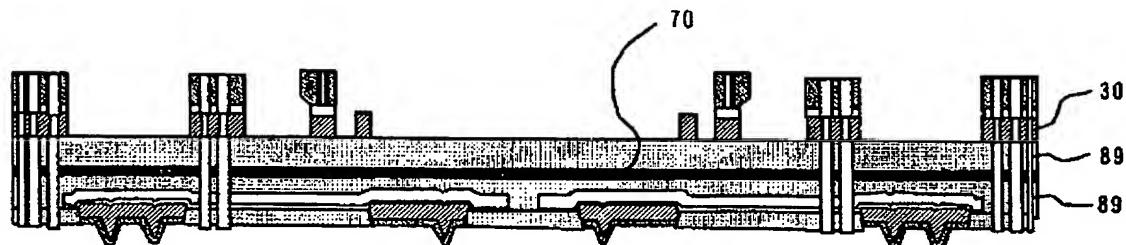
[図7]



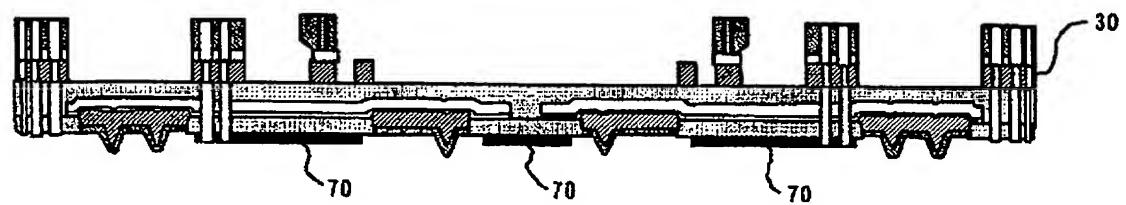
[図8]



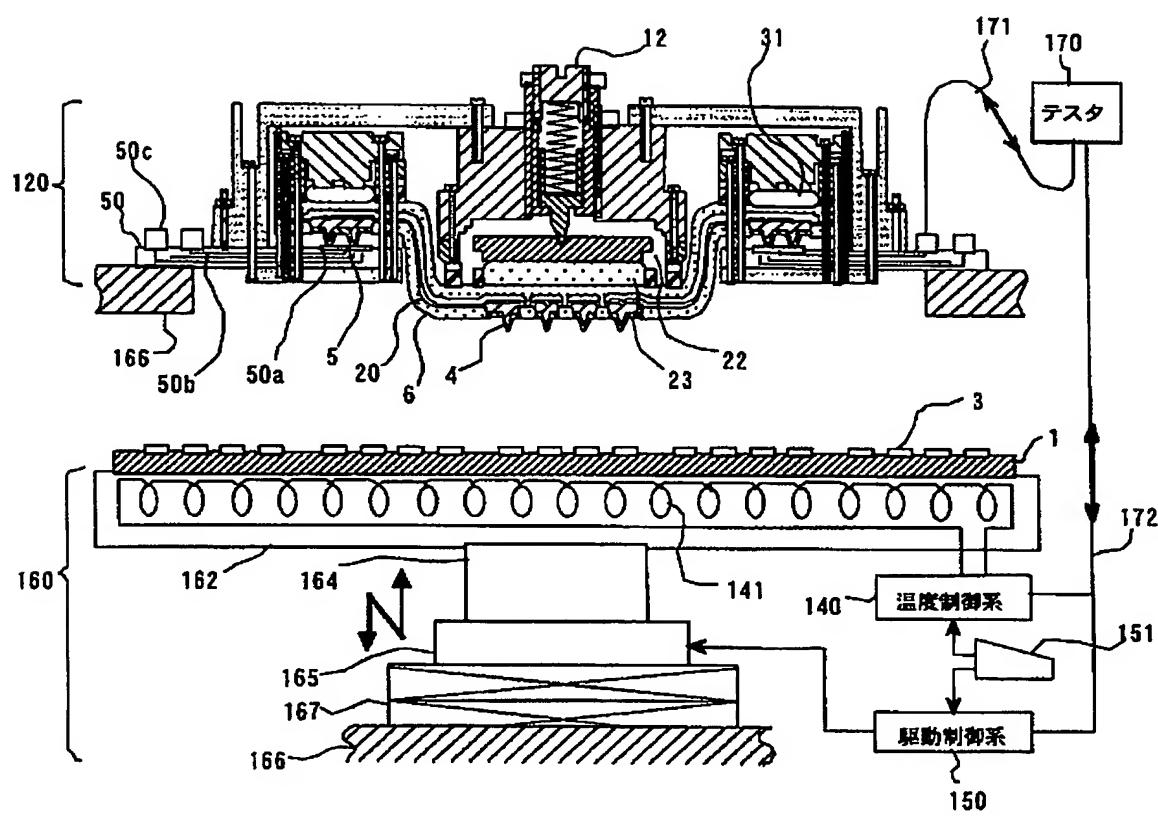
[図9]



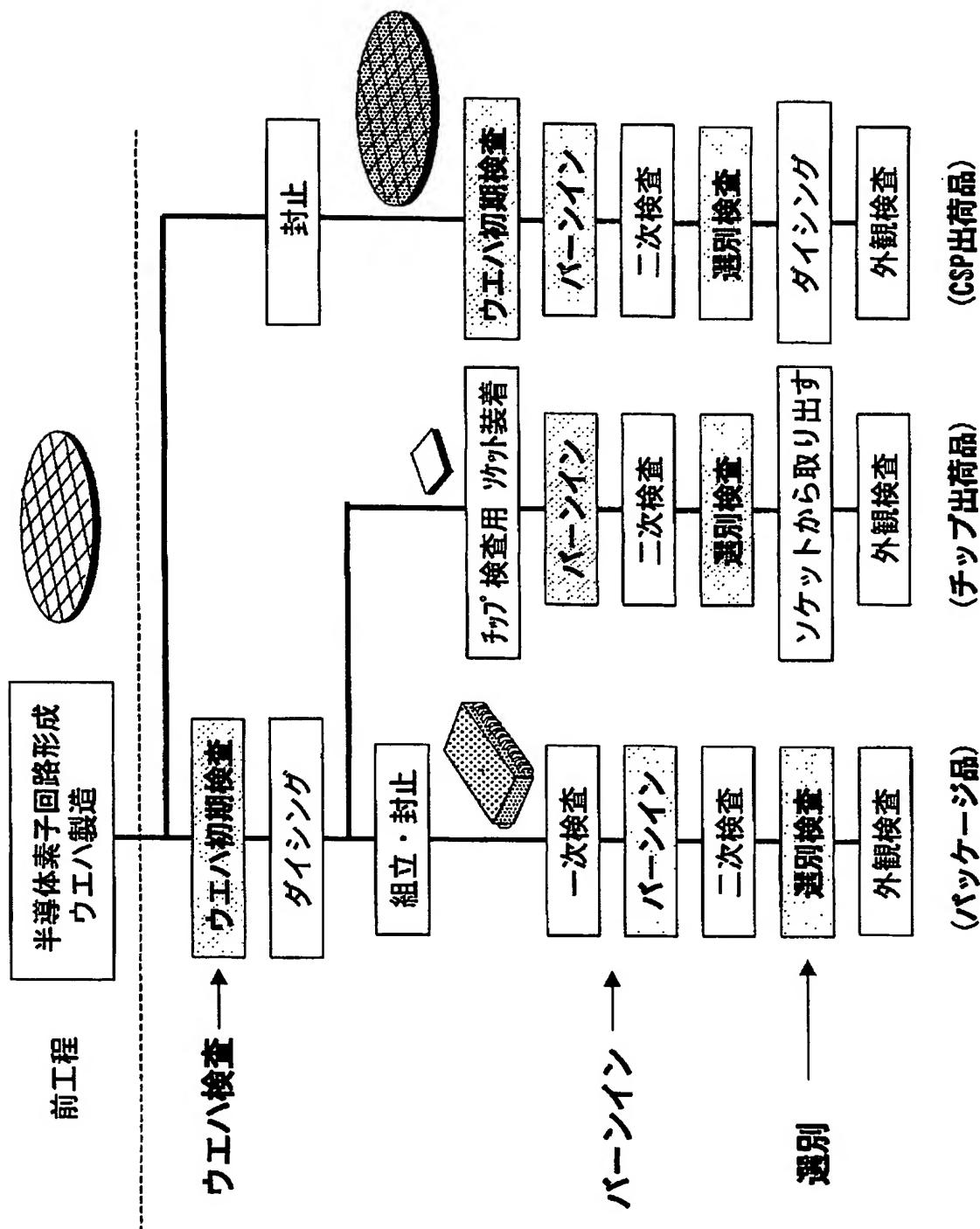
[図10]



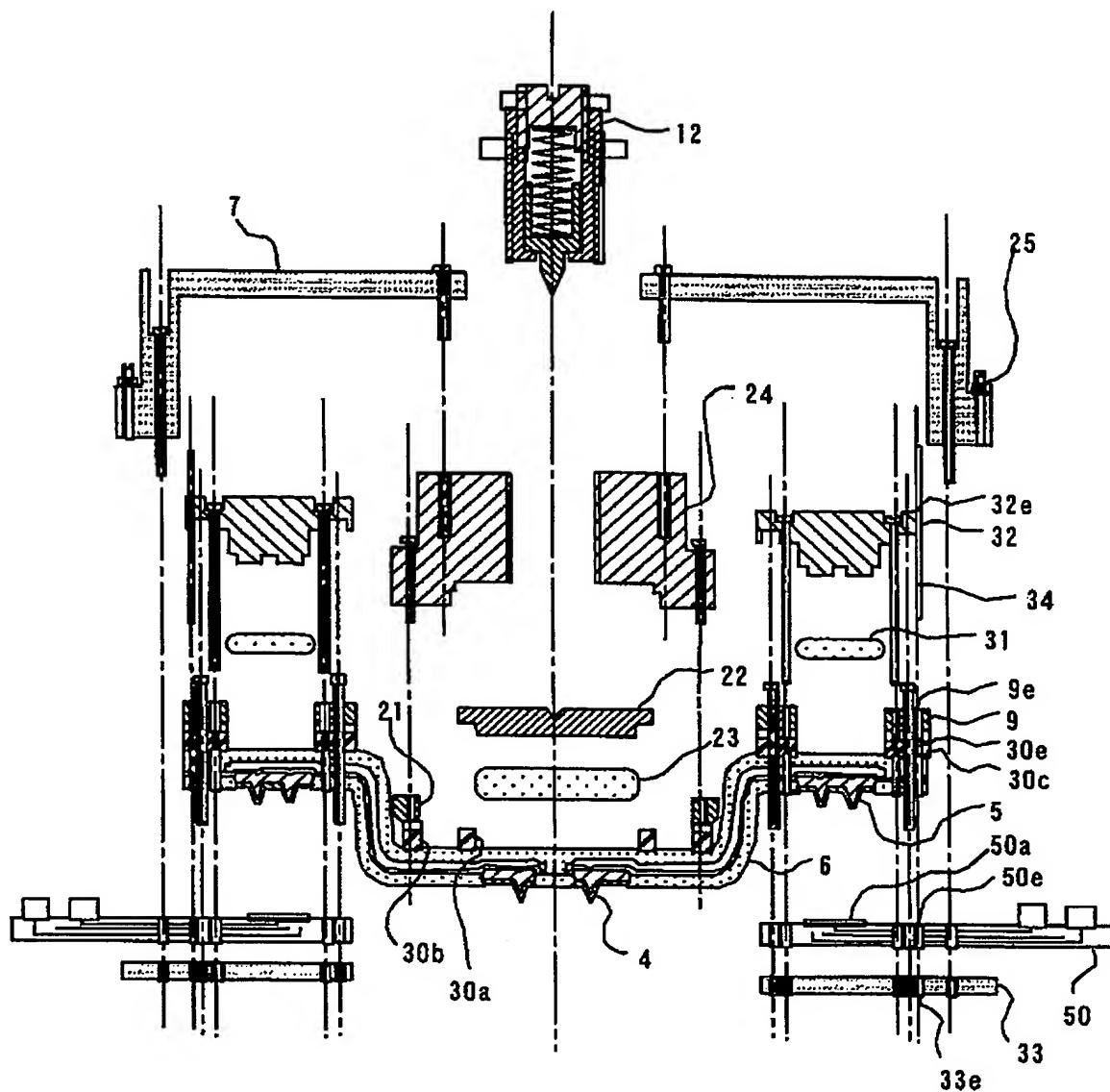
[図11]



[図12]

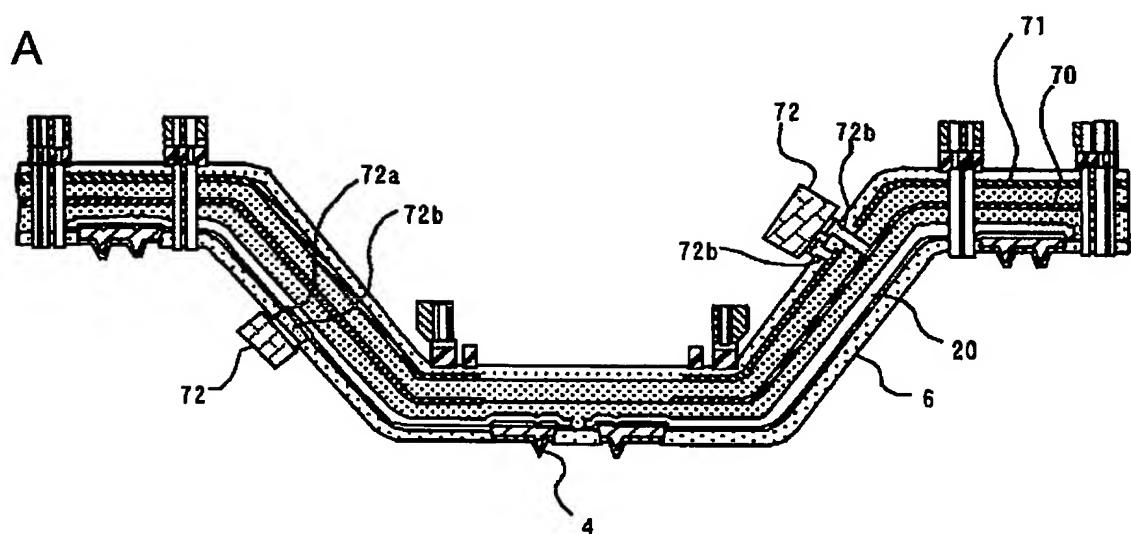


[図13]

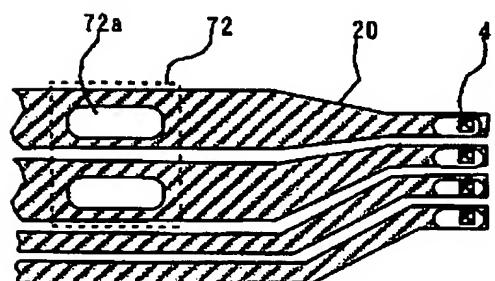


[図14]

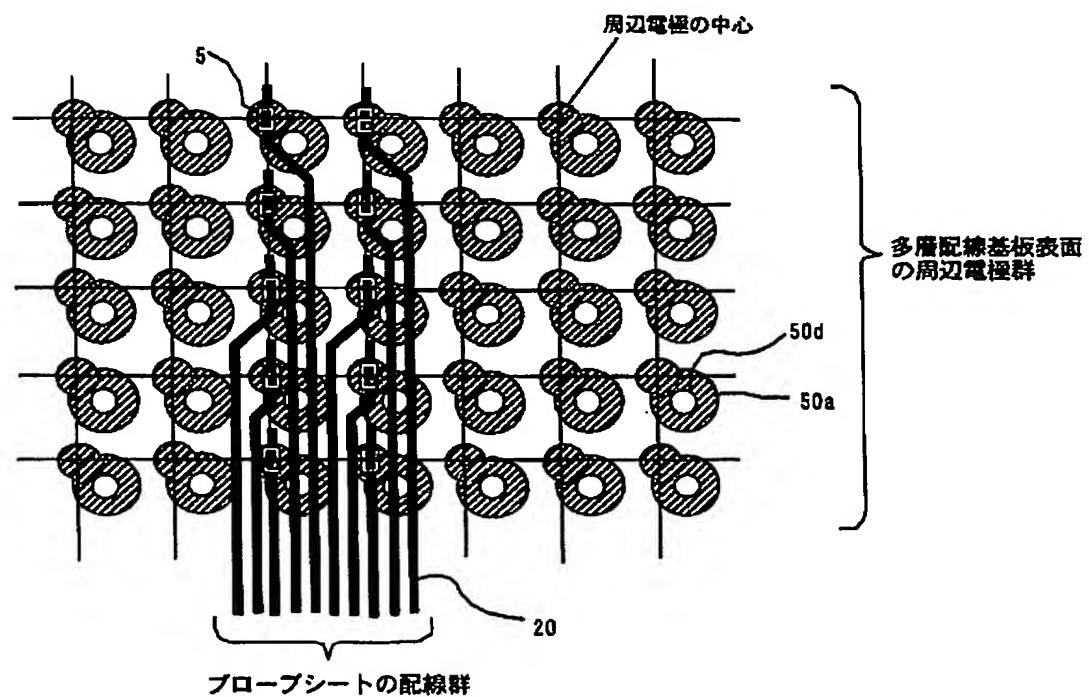
A



B



[図15]



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/009412

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
Int.Cl<sup>7</sup> G01R1/073

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
Int.Cl<sup>7</sup> G01R1/06-073, 31/26-3193Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  
Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004  
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2000-150594 A (Hitachi, Ltd.), 30 May, 2000 (30.05.00), Par. Nos. [0026] to [0029], [0035] to [0037], [0042] to [0054]; Figs. 2, 6 to 10 & EP 0999451 A2 Par. Nos. [0066] to [0071], [0079] to [0084], [0093] to [0119] Figs. 2, 6 to 10	1-19, 14-23
Y	JP 2001-091543 A (Hitachi, Ltd.), 06 April, 2001 (06.04.01), Par. No. [0037]; Figs. 1 to 2 & US 6507204 B1 Column 7, lines 30 to 43; Figs. 1 to 2	11 10, 12, 13
		11

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

## \* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
02 September, 2004 (02.09.04)Date of mailing of the international search report  
21 September, 2004 (21.09.04)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP2004/009412

## A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. C17 G01R 1/073

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C17 G01R 1/06-073, 31/26-3193

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2000-150594 A (株式会社日立製作所) 2000.05.30, [0026]-[0029], [0035]-[0037], [0042]-[0054], 図2, 6-10	1-9, 14-23
Y	& EP 0999451 A2, [0066]-[0071], [0079]-[0084], [0093]-[0119], FIG. 2, 6-10	11
Y	JP 2001-091543 A (株式会社日立製作所) 2001.04.06, [0037], 図1-2 & US 6507204 B1, column 7, lines 30-43, FIG. 1-2	10, 12, 13

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリ

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02.09.2004

国際調査報告の発送日

21.9.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員)

堀 圭史

2S 3005

電話番号 03-3581-1101 内線 3258

Post  
Availabile  
Copy